PTO/SB/21 (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
rwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

## **TRANSMITTAL FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/064,355	· · · · · ·
Filing Date	07/04/2002	
First Named Inventor	Kung-Yu Hsu	
Group Art Unit		
Examiner Name		
Attorney Docket Number	AMIP0016USA	

Total Number of	Pages in This Submi					
ENCLOSURES (check all that apply)						
Fee Transmittal Form Fee Attached Amendment / Reply After Final Affidavits/decl: Extension of Time Recommend Express Abandonment Information Disclosur Certified Copy of Prior Document(s) Response to Missing Incomplete Application Response to Munder 37 CFR	quest  nt Request  re Statement  ority  Parts/ on  Aissing Parts	Assignment Papers (for an Application)  Drawing(s)  Licensing-related Papers  Petition  Petition to Convert to a Provisional Application  Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address  Terminal Disclaimer  Request for Refund  CD, Number of CD(s)  After Allowance Communication to Group Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter  Other Enclosure(s) (please identify below):  After Allowance Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter  Other Enclosure(s) (please identify below):				
		TO A DOLLOANT ATTORNEY OF AGENT				
Firm or Individual name	WINSTON HS					
Signature	Win	stostare				
Date	7/8/	72001				
		CERTIFICATE OF MAILING				
I hereby certify that this corre mail in an envelope address	espondence is being ed to: Commissioner	deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class r for Patents, Washington, DC 20231 on this date:				
Typed or printed name						
Signature		Date  Date  Date  Date  Date				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 0.2 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

APR 17 2006

APR 17 2006

Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond

PTO/SB/17 (10-01)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE TRANSMITTAL for FY 2002

Patent fees are subject to annual revision.

TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00

Complete if Known				
Application Number	10/064,355			
Filing Date	07/04/2002			
First Named Inventor	Kung-Yu Hsu			
Examiner Name				
Group Art Unit				
Attorney Docket No.	AMIP0016USA			

METHOD OF PAYMENT	FEE CALCULATION (continued)					
1. The Commissioner is hereby authorized to charge	3. ADDITIONAL FEES					
Indicated lees and credit any overpayment	Large Small Entity Entity					
Account 50-0801	Fee Fee Fee Fee Fee Description	Fee Paid				
Number Deposit North America International Patent	Code (\$) Code (\$)					
Account Name	the provisional filing for or					
Charge Any Additional Fee Required	127 50 227 25 Surcharge - late provisional filing fee or cover sheet					
Under 37 CFR 1.16 and 1.17	139 130 139 130 Non-English specification					
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27	147 2,520 147 2,520 For filing a request for ex parte reexamination					
2. Payment Enclosed:	112 920* 112 920* Requesting publication of SIR prior to					
Check Credit card Money Other	Examiner action					
FEE CALCULATION	113 1,840° 113 1,840° Requesting publication of SIR after Examiner action					
	115 110 215 55 Extension for reply within first month					
1. BASIC FILING FEE	116 400 216 200 Extension for reply within second month					
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid	117 920 217 460 Extension for reply within third month					
Code (\$) Code (\$)	118 1,440 218 720 Extension for reply within fourth month					
101 740 201 370 Utility filing fee 106 330 206 165 Design filing fee	128 1,960 228 980 Extension for reply within fifth month					
107 510 207 255 Plant filing fee	119 320 219 160 Notice of Appeal					
108 740 208 370 Reissue filing fee	120 320 220 160 Filing a brief in support of an appeal					
114 160 214 80 Provisional filing fee	121 280 221 140 Request for oral hearing 138 1.510 138 1.510 Petition to institute a public use proceeding					
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00						
	n with the service surject entire of					
2. EXTRA CLAIM FEES	(4,1,200 27, 072					
Extra Claims below Fee Paid	142 1,280 242 640 Utility issue fee (or reissue)  143 460 243 230 Design issue fee					
Independent 3** = X =	144 620 244 310 Plant issue fee					
Claims Multiple Dependent	122 130 122 130 Petitions to the Commissioner					
	123 50 123 50 Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	·				
Large Entity Small Entity	126 180 126 180 Submission of Information Disclosure Stmt					
Fee Fee Fee Fee Description Code (\$) Code (\$)	581 40 581 40 Recording each patent assignment per property (times number of properties)					
103 18 203 9 Claims in excess of 20	Till was basical offer final rejection					
102 84 202 42 Independent claims in excess of 3	146 740 246 370 Filing a submission after final rejection (37 CFR § 1.129(a))					
104 280 204 140 Multiple dependent claim, if not paid	149 740 249 370 For each additional invention to be					
109 84 209 42 ** Reissue independent claims over original patent	examined (37 CFR § 1.129(b))					
110 18 210 9 ** Reissue claims in excess of 20	179 740 279 370 Request for Continued Examination (RCE)					
and over original patent	169 900 169 900 Request for expedited examination of a design application					
SURTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (specify)					
SUBTOTAL (2) (3) 0.00	/ex	0.00				
**or number previously paid, if greater; For Reissues, see above	*Reduced by Basic Filing Fee Paid SUBTOTAL (3) (4)					

SUBMITTED BY

Name (Print/Type)

WINSTON HSU

Registration No. (Attorney/Agent)

(Attorney/Agent)

Date

Complete (if applicable)

Telephone 886-2-8923-7350

Date

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.



Please ype a plus sign (+) inside this box →

PT O/SE/02B (3 € 7)

Approved for use through 9/30/93. OMB 065 1-0032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

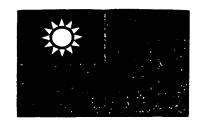
valid OMB control number.

# DECLARATION --- Supplemental Priority Data Sheet

DECLAIG							
Additional foreign applic	ations:					Certified Copy	Attached?
Prior Foreign Application		1		n Filing Date W/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	YES NO	
Number(s)	Cour	try C		125/2002			日
091108587	Taiwan,	£,0,0		29/0			1000
					10000000000	)00000000	)000000
						000	
Additional provisiona	l applications:				Filing Date	(MM/DD/YYY)	<u>')                                    </u>
Арр	lication Num						
·		• .	-				
Additional U.S. applic	ations:			T	, dili - Data	Parent Pa	itent Number
U.S. Parent Appl Number	ication	PCT Par Numb		Paren (MM	t Filing Date //DD/YYYY)	(if ap	plicable)
	_						
							he individual case

Burden Hour Statement. This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any Burden Hour Statement This form is estimated to take 0.4 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information. Officer, Patent and Trademark Office, comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information. Officer, Patent and Trademark Office, comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information. Officer, Patent and Trademark Office, comments on the amount of time, you are required to complete this form should be sent to the Chief Information. Officer, Patent and Trademark Office, comments on the amount of time. The chief Information of the patents of the chief Information of the patents of the chief Information. Officer, Patent and Trademark Officer, Patent and Trademark Officer. The chief Information of the patents of the patents of the chief Information of the patents of the





## 인도 인도 인도 인도

## 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunde

申 請 日: 西元 2002 年 04 月 25 日

Application Date

申 請 案 號: 091108587

Application No.

申 請 人:聯笙電子股份有限公司

Applicant(s)

局 長 Director General

# 陳明邦

發文日期: 西元 2002 年 \_ 6 \_ 月

Issue Date

發文字號: 09111011565

Serial No.



申請日期:	案號:	
類別:		

(以上各欄由本局填註)

(以上合徽)	一——	
		發明專利說明書
	中文	以二極體與金氧半電晶體組合的壓控電容電路及相關電路
、 發明名稱	英文	Voltage-Controlled Capacitor Circuit And Related Circuitry With Diode And MOS Varactors
	姓 名 (中文)	1. 徐光宇 2. 鄭智宏
, , 二 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(英文)	1. Hsu, Kung-Yu 2. Cheng, Chih-Hung
	國籍	1. 中華民國 2. 中華民國
	住、居所	1. #華氏國 2. 「華民國 1. 桃園市宏昌八街一0九號十一樓 2. 台北市基隆路三六四巷二號十一樓
	姓 名 (名稱) (中文)	1. 聯笙電子股份有限公司
	姓 名 (名稱) (英文)	1. AMIC Technology (Taiwan) Inc.
J	國籍	1. 中華民國
申請人	住、居所 (事務所)	1. 新竹科學工業園區新竹市力行六路五號六樓
	代表人 姓 名 (中文)	1. 陳 焜 錄
	代表人 姓 名 (英文)	1. Chen, Kun-Luh

四、中文發明摘要 (發明之名稱:以二極體與金氧半電晶體組合的壓控電容電路及相關電路)

本發明提供一種壓控電容電路及相關電路。該壓控電容電路由至少一金氧半電晶體可變電容、一二極體可變電容及/或一電容值固定的電容組合形成;兩可變電容及電容值固定之電容係以串聯或並連的方式互相電連接,以共同組合出較佳的壓控電容特性。

英文發明摘要 (發明之名稱:Voltage-Controlled Capacitor Circuit And Related Circuitry With Diode And MOS Varactors)

A voltage-controlled capacitor circuit and related circuitry. The voltage-controlled capacitor circuit includes a metal-oxide semiconductor (MOS) varactor, a diode varactor and/or a capacitor with fixed capacitance. The MOS varactor, the diode varactor and the capacitor are electrically connected in parallel or in series to form a capacitor with preferred character of voltage-controlled capacitance.



本案已向

國(地區)申請專利

申請日期

案號

主張優先權

無

有關微生物已寄存於

寄存日期

寄存號碼

無

#### 五、發明說明 (1)

### 發明之領域:

本發明係提供一種壓控電容電路及其相關應用電路,尤指一種以金氧半電晶體可變電容及二極體可變電容來組合出較佳壓控電容特性的壓控電容電路及其相關應用電路。

## 背景說明:

不論是電阻-電容(RC)濾波器的濾波特性(像是濾波器的通帶頻寬),或是電感-電容(LC)壓控震盪器的震盪

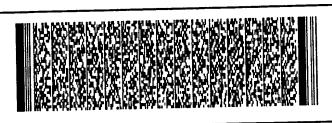




五、發明說明 (2)

特性(像是震盪訊號的頻率),都可以用改變電容值的方 式來加以調整。請參考圖一。圖一為一習知壓控震盪器 的電路示意圖。壓控震盪器10以兩個匹配的金氧半電 T1、 T2形成一震盪電路,以電壓源 Vd提供偏壓。其中 體 T1、T2的 閘極各做為一震盪輸入端,分別電連於節點 Np2及節點 Np1; 電晶體 T1、 T2的 汲極 (drain)各 做 為 一 震 盪輸出端,分別連接於節點 Np1及節點 Np2。電連於電晶體 T 2源極的電流源 I p 0則用來提供偏壓電流。兩個互相 匹配的二極體 Dp1、Dp2各做為一可變電容(varactor),各 二極體的陰極分別電連於節點 Np1、No2,各二極體的陽極 則以控制電壓 V c O來將這兩個二極體 D p 1、 D p 2逆向偏壓, 使得這兩個二極體的 p-n接面能出現空乏區 (depletion region),並使二極體 Dp1、Dp2能在其陰極陽極間等效為 一電容。二極體 Dp1、Dp2提供的電容,連同兩互相匹配的 電感 Lp1、 Lp2,就能形成電感 -電容共振槽 (LC tank)。二 極體 Dpl提供的電容與電感 Lpl可視為電晶體 Tl的負載, 電晶體Tl由其閘極接收一震盪輸入訊號再經由節點Npl輸 出訊號至該負載時,等效上也就是改變了該震盪輸入訊號 竹相位;該震盪輸入相位會經由節點 Np1饋入電晶體 T2的 閘極,經由電晶體 T2再次改變其相位後,再度於節點 Np2 迴授至電晶體 T1的 閘極。經由上述的迴授配置,就能在節 點 Np1、 Np2產生出週期震盪的震盪訊號。

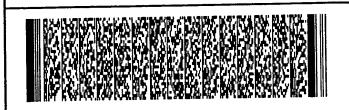
由於壓控震盪器10是以電感一電容配置來共振出震盪





### 五、發明說明 (3)

訊號,震盪訊號的震盪頻率就正比於 /(III·CO);其中LO為 電 感 Lp1或 Lp2的 電 感 值 ; C0則 是 二 極 體 Dp1或 Dp2提 供 的 等 效電容值。在壓控震盪器 10中,二極體 Dp1、Dp2分別做為 一電壓控制的可變電容;改變二極體 Dp1、Dp2陽極陰極間 (譬如說是改變控制電壓 VcO)的大小,就能改變 這兩個二極體於陽極陰極間提供的等效電容,進一步改變 10產生之震盪訊號的頻率;達到壓控震盪頻率 壓控震盪器 請繼續參考圖二A與圖二B。圖二A、B為二極體做 **为一可變電容時,其陽極陰極間跨壓與兩極間等效電容之** 關係示意圖。當一二極體 D0等效於一可變電容 極 Nal、陽極 Na2間提供一等效電容 CaO時,陰極、陽極間 跨壓 Val 2與電容 Ca 0電容值兩者間的關係,就如同圖二 A所 其中圖二 A之橫軸為電壓 Val 2的電壓值,縱軸則是等 效電容 CaO的電容值。另一方面,圖二 B則是電容 CaO開根 號後之倒數值,與電壓 Val2的關係示意圖 圖二 B之横軸 亦為電壓 Val2的電壓值。當二極體 D0用於電感-電容壓控 震盪器時,電路設計者也會希望能以線性變化的控制電壓 來控制壓控震盪器的震盪頻率(也就是控制電壓與震盪頻 率間有線性的關係);由於震盪頻率正比於 √√cao (電感值 YCOO之間最好也有線性的關 為定值),代表控制電壓與 係。但就如圖二 B所示,二極體 D O兩端間跨壓 Va 1 2與電容 Ca0之 √Ca0值的關係並非理想的線性,導致電路設計時的



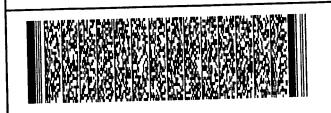


## 五、發明說明(4)

困難。而且,二極體可變電容的壓控電容特性,多半取決於半導體的特性(如摻雜濃度等),無法由電路設計的方式來加以調整,也使得二極體可變電容的電路設計缺乏使用上的彈性。

## 發明概述:

因此,本發明之主要目的,在於提供一種以二極體可變電容、金氧半電晶體可變電容與電容值固定的電容共同





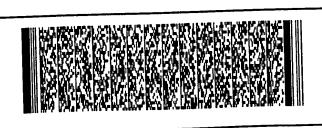
## 五、發明說明 (5)

形成的壓控電容電路,能夠合成出多樣的壓控電容特性,符合各種壓控震盪器或濾波器的壓控電容需要。

## 發明之詳細說明:

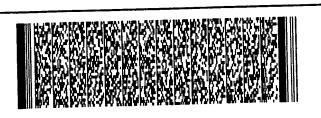
請參考圖四;圖四為本發明中壓控電容電路一實施例20的電路示意圖。在此實施例中,壓控電路20分別以節點 N2做為兩輸出端,在此兩輸出端之間,壓控電容電路20中電路 20能等效成一壓控電容 C12。壓控電容電路20中費 B1、兩個電容值固定中費 B1、兩個電容值固定定的電子 C1、C2,以及用來將偏壓電壓 Vbias2分別耦合至節點 N3、N4的耦合阻抗 Z1、Z2。電晶體 M1做為一第一可變電容的,其間極為第一可變電容的一端,電連於節點 N3,形成第一可變電容的另一端。同樣地,二極體 D1提供一 pn接面做為





## 五、發明說明 (6)

第二可變電容,其陽極為第二可變電容的一端 二極體 D1的陰極則為第二可變 另 電 容 的 N1。如前所述,以電晶體 M1形成的第一 節點 其兩端間的電容值可由第一可變電容兩端間的 而由節點 N3饋入的偏壓電壓 Vbias1以及由節點 Vcl,就能用來控制第一可變電容於節點 饋入的控制電壓 對二極體 D1形成的第二 N 3間提供的等效電容。同理, 容來說,節點 N1的控制電壓 Vc1以及由節點 N4饋入 的偏壓電壓 Vbias2,兩電壓間的電壓差也能用來控制第二 為了控制上的 可變電容於節點 N1及 N4間提供的等效電容。 方便,本發明中的偏壓電壓 Vbias1及 Vbias2兩者的電壓值 可以是固定的;這樣一來,只要改變控制電壓Vcl的大 ,就能控制第一可變電容及第二可變電容的電容值。用 來耦合偏壓電壓 Vbias1、 Vbias2至節點 N3、 N4的耦合阻抗 ;由於偏壓電壓 Vbias1、 Vbias2為直 可以是電阻或是電感 感形式的耦合阻抗可以在不干擾節點 N3、N4高 將偏壓電壓 Vbias1、 Vbias2耦 頻 交 流 電 壓 震 盪 的 情 形 下 , 電感形式的耦合阻抗 N3、N4(對高頻訊號來說, 合至節點 ,電感形式的耦合阻抗則形同 直流電壓來說 對 電容值固定的電容 C1、C2,分別電連於節點 短路) N2、N4之間,可用來調整第一可變電容及第二 N3與節點 容的加權比重。如圖四所示,壓控電容電路20於節點 N1、 N2間提供的電容 C12, 是由電容 C1與第一可變電容 (電晶體 M1) 串連,電容 C2與第二可變電容(二極體 D1)

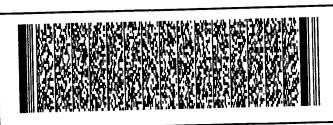




## 五、發明說明 (7)

串連,再將上述兩者並連而形成的;故在設計電路時改變電容 C1或是電容 C2的值,可改變第一可變電容與第二可變電容對電容 C12電容值的影響。舉例來說,若將電容 C1的電容值增加,會使總電容 C12的壓控電容特性更偏向第一可變電容的壓控電容特性。

P(micron), 二極體面積為 100μ m²。如圖五所示,若如習知技術般僅使用金氧半電晶體可變電容,或僅使用二極體可變電容,其壓控電容特性會分別像曲線 22C、 22B所示,其壓控電容特性能的成分會較為明顯,增加電路設計上的困難。相較之下,本發明之壓控電容電路 20在適當地合成電晶體可變電容及二極體可變電容後,其合成後的壓





五、發明說明 (8)

請參考圖六。圖六即為圖四中壓控電容電路 20運用於一震盪器 30的示意圖。震盪器 30以電壓源 Vd提供偏壓,以電流源 IO提供偏壓電流,並以金氧半電晶體 Q1、 Q2形成一電盪電路,兩個壓控電容電路 20提供的等效 電容和電感 L1、 L2則形成電感 -電容共振槽 (LC tank)。電晶體 Q1、 Q2的 開極可視為震盪輸入端,節點 N9、 N1 0則 做為震盪輸出端;輸入至電晶體 Q1 閘極的震盪輸入訊號會輸出至電感 -電容共振槽的負載,並經由電晶體 Q1的節點 N9輸入至電晶





五、發明說明 (9)

體 Q2的開極;電晶體 Q2再度以節點 N10的電感 -電容共振槽改變震盪訊號的相位,並迴授至電晶體 Q1的開極。經由不斷地迴授,就能在節點 N9、 N10產生出週期震盪的震盪訊號了。如前所述,改變控制電壓 Vc1的大小,就能改變壓控電容電路提供的電容大小,進一步改變震盪訊號的頻率,達到壓控震盪器的目的。當然,本發明於圖四中的壓控電路 20,也能運用於圖一中之震盪器 10。

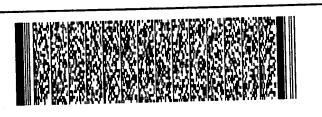
請參考圖七。圖七為本發明中壓控電容電路的另一實 他例 40。壓控電容電路 40以節點 N5、 N8做為兩輸出端,能 在節點 N5、N8間提供一等效電容 C58。在壓控電容電路 40 中,是以金氧半電晶體 M 2做為一第一可變電容,以節點 N5、N6的偏壓電壓 Vbias3(經由耦合阻抗 Z3饋入)及控制 電壓 Vc2來控制第一可變電容在節點 N5、N6間提供的電容 大小。二極體 D2則做為一第二可變電容,其於節點 N6、N7 間所提供的電容大小則由控制電壓 Vc2及偏壓電壓 Vbias4 (經由耦合阻抗 Z4饋入)來控制。最後,在節點 N7、N8 間,則設有電容值固定的電容C3。經由串連的第一可變電 文、第二可變電容及電容C3,壓控電容電路40就能在節點 N5與 N8間提供一等效電容 C58。類似於圖四中的壓控電容 電路 20, 壓控電容電路 40也可將偏壓電壓 Vbias3、 Vbias4 的電壓值固定,以控制電壓 Vc2來控制第一可變電容及第 二可變電容個別提供的電容;電容 C 3則用來調節第一可變 電容、第二可變電容對等效電容 C58的貢獻。





## 五、發明說明 (10)

不論是圖四中的壓控電容電路20,或是圖七中的壓控 電容電路40,都能以偏壓電壓及控制電壓來控制第一可 容及第二可變電容提供的電容,並能以電容值固定的 C1、C2及C3,來調整各壓控電容電路中第一及第二可變 容的加權比重,組合出各種壓控電容特性。像在圖五 第二可變電容組合出控制 ,就顯示了以第一可變電容 Y/CO2間的線性壓控電容特性。除此之外,利用 Vcl與 還能組合出其他的壓控電容 明揭露的壓控電容電路, 請參考圖八A至圖八D。圖八A至圖八D例舉了四個本 發明中壓控電容電路可以組合出來的壓控電容特性 的横軸為控制電壓Vc的大小(如壓控電容電路 20中的控制 電壓 Vc1,或是壓控電容電路 40中的控制電壓 Vc2) 横軸標示中的電容Cv則是壓控電容電路所能提供的 (即圖四中的電容 C12,或是圖七中的電容 C58) 八B是電容Cv開根號後的倒數值與控制電壓呈線性的壓 圖八 C、八 D則是電容 Cv電容值與控制電壓呈 控電容特性, 線性的壓控電容特性。如前所述,圖八A、B的壓控電容 と適用於壓控震盪器中以控制電壓線性地控制震盪頻率。 圖八 C、 D的壓控電容特性則適用於電容-電阻(RC)濾波器 。此外,本發明的壓控電容電路也能合成出控制電壓Vc 與 (Cv)²( 電容 Cv電容值之平方) 間的線性壓控電容特 性

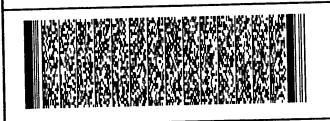


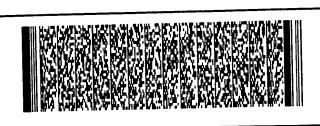


## 五、發明說明 (11)

請參考圖九。圖九為本發明壓控電容電路另一實施例 50之電路圖。除了圖四、圖七中的並連、串連配置外 發明也可以混合串連及並連配置,組合出不同的壓控電容 電路。如圖九中的壓控電容電路50,就是以金氧半電晶體 M3以及兩個二極體 D3、D4來當作三個可變電容 電容值固 定的電容 C4、 C5及 C6則 可調節三個可變電容組合的加權比 。請注意本發明中也能以二極體形式連接的雙載子接面 電晶體或是金氧半電晶體來當作pn接面二極體可變電 像圖九中的二極體 D4, 就是以一雙載子接面電晶體以二極 體形式連接而成(也就是集極與基極相連接,以集極、射 極分別作為此二極體的陽極、陰極)。由節點 N11饋入的 控制電壓 Vc3以及經由耦合阻抗 Z5饋入的偏壓電壓 Vbias5 兩者間的電壓差可控制二極體 D3在節點 N11、 N12間提供的 同理,節點 N13的控制電壓 Vc4配合節點 N14經由 耦合阻抗 Z6饋入的偏壓電壓 Vbias6、節點 N15以耦合阻抗 Z7饋入的偏壓電壓 Vbias7,就能控制二極體 D4、電晶體 M3 分 別 於 節 點 N13、 N14與 節 點 N13、 N15間 提 供 的 電 容。 多可變電容及各電容值固定的電容,壓控電容電路 50就能 在節點 N11、 N16間提供等效電容 Ct。在實做時,可將控 電壓 Vc3、 Vc4設定為相同的電壓,簡化控制電壓的控制配 置。

另外,本發明中的壓控電容電路也可以不設置電容值



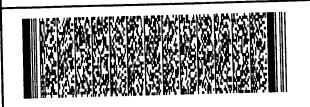


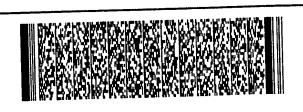
五、發明說明 (12)

)

固定的電容。舉例來說,圖四中的壓控電容電路 20,也可取消電容 C1、C2,直接將節點 N3、N4連接於節點 N2;在此種情況下,也可以不設置偏壓電壓 Vbias1、Vbias2;當然耦合阻抗 Z1、Z2也可一併省去。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利的涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明:

圖一為一習知之二極體可變電容用於一壓控震盪器之電路圖。

圖二 A、二 B為一習知之二極體可變電容壓控電容特性的示意圖。

圖三為一習知之金氧半電晶體可變電容壓控電容特性之示意圖。

圖四為本發明中壓控電容電路一實施例的電路示意

回。 圖五為圖四中壓控電容電路壓控電容特性合成之示意 圖。

圖六為圖四中壓控電容電路運用於一震盪器之電路圖。

圖七為本發明中壓控電容電路另一實施例的電路示意圖。

圖八 A至圖八 D為本發明中壓控電容電路所能合成出來的各種壓控電容特性。

圖九為本發明中壓控電容電路另一實施例之電路圖。

圖式之符號說明:

10 20 · 40 · 50 壓控震盪器壓控電容電路



圖	式	簡	單	說	明	
---	---	---	---	---	---	--

22A-22D

30

V d

Lp1-Lp2 L1 L2

Na1

Na2

Val2 \ Vb12

Vbias1-Vbias7

Dp1 Dp2 D0-D4

CaO、CbO、C1-C6、C12、C58、Cv、Ct 電容

Np1-Np2 Nb1-Nb2 N1-N16

Ip0 · I0

T1 · T2 · M0 - M3 · Q1 · Q2

VcO · Vc1 - Vc4 · Vc

Z1 - Z7

曲線

震盪器

電壓源

電感

陰 極

陽極

電壓

偏壓電壓

二極體

節點

電流源

電晶體

控制電壓

耦合阻抗

1. 一種壓控電容 (voltage-controlled capacitor)電路,用來於一第一輸出端及一第二輸出端間提供一電容;該壓控電容電路包含有:

一第一可變電容 (varactor), 其具有兩端, 其中一端連接於該第一輸出端;

而該第一可變電容包含有一金氧半電晶體,該電晶體 之源極與汲極連接於該第一可變電容的一端,該電晶體之 閘極連接於該第一可變電容的另一端;

而該第一可變電容的兩端分別用來接收一第一偏壓電壓與一第一控制電壓,以根據該第一偏壓電壓與該第一控制電壓間的電壓差改變該第一可變電容之兩端間的電容值;以及

一第二可變電容 (varactor),其具有兩端,其中一端連接於該第二輸出端;

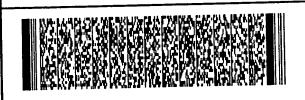
而該第二可變電容包含有一電晶體,電連於該第二可變電容的兩端間,用來在該第二可變電容的兩端間形成一pn接面(pn-junction);

該第二可變電容的兩端分別用來接收一第二偏壓電壓一第二控制電壓,以根據該第二偏壓電壓與該第二控制電壓間的電壓差改變該第二可變電容兩端間的電容值。

2. 如申請專利範圍第 1項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第一可變電容的一端與該第一輸出端之間。



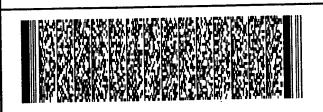
- 3. 如申請專利範圍第 1項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二可變電容的一端與該第二連接端之間。
- 4. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第一可變電容未與該第一輸出端連接的一端以及該第二輸出端之間。
- J. 如申請專利範圍第 1項之壓控電容電路,其中該第一可變電容係電連於該第一輸出端與該第二輸出端之間。
- 6. 如申請專利範圍第 5項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二輸出端與該第一可變電容之間。
- 7. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其中該第二可變電容係電連於該第一輸出端與該第二輸出端之間。
- 8. 如申請專利範圍第7項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二輸出端及該第二可變電容之間。
- 9. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其中該第二



)

可變電容係連接於該第一可變電容與該第二輸出端之間。

- 10. 如申請專利範圍第9項之壓控電容電路,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二可變電容與該第二輸出端之間。
- 11. 如申請專利範圍第 9項之壓控電容電路,其中該第二可變電容接收該第二控制電壓的一端係連接於該第一可變電容接收該第一控制電壓的一端。
- 12. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其中該第一偏壓電壓之電壓值係一固定值。
- 13. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其中該第二偏壓電壓之電壓值係一固定值。
- 14. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其係使用於一壓控震盪器。
- 15. 如申請專利範圍第14項之壓控電容電路,其中該壓控震盪器包含有:
- 一電感,電連於該壓控震盪電路;
- 一震盪電路,電連於該電感,用來依據該電感及該壓控電容電路共振的結果輸出一震盪訊號。



- 16. 如申請專利範圍第 1項之壓控電容電路,其中該二極體係一二極體形式連接的雙載子接面電晶體 (BJT, Bipolar Junction Transistor)。
- 17. 如申請專利範圍第1項之壓控電容電路,其中該二極體係以一二極體形式連接的金氧半電晶體。
- 18. 一種震盪器,用來提供一震盪訊號;
- 該震盪器包含有:
- 一種壓控電容 (voltage-controlled capacitor)電 路,用來於一第一輸出端及一第二輸出端間提供一電容; 該壓控電容電路包含有:
- 一第一可變電容 (varactor),其具有兩端,其中一端連接於該第一輸出端;而該第一可變電容包含有一金氧半電晶體,該電晶體之源極與汲極連接於該第一可變電容的 一端,該電晶體之閘極連接於該第一可變電容的另一端;
- 而該第一可變電容的兩端分別用來接收一第一偏壓電壓與一第一控制電壓,以根據該第一偏壓電壓與該第一控制電壓間的電壓差改變該第一可變電容之兩端間的電容值;以及
- 一第二可變電容 (varactor),其具有兩端,其中一端連接於該第二輸出端;
  - 而該第二可變電容包含有一電晶體,電連於該第二可



變電容的兩端間,用來在該第二可變電容的兩端間形成一 pn接面(pn-junction);

該第二可變電容的兩端分別用來接收一第二偏壓電壓與一第二控制電壓,以根據該第二偏壓電壓與該第二控制電壓間的電壓差改變該第二可變電容兩端間的電容值;

- 一電感,連接於該壓控電容電路;
- 一震盪電路,其具有一震盪輸入端及一震盪輸出端; 該震盪輸入端用來接收一震盪輸入訊號;該震盪輸出 端電連於該電感及該壓控電容電路,用來根據該第一輸入 為及該第二輸入端間的電容與該電感共振的結果,改變該 震盪輸入訊號的相位,並將相位改變後的震盪輸入訊號迴
- 19. 如申請專利範圍第18項之震盪器,其中該第一可變電容係電連於該第一輸出端與該第二輸出端之間。

授 (feedback)至該震盪輸入端,以產生該震盪訊號。

- 20. 如申請專利範圍第19項之震盪器,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二輸出端與該第一可變電容之間。
- 21. 如申請專利範圍第 18項之震盪器,其中該第二可變電容係電連於該第一輸出端與該第二輸出端之間。
- 22. 如申請專利範圍第21項之震盪器,其另包含有一電容



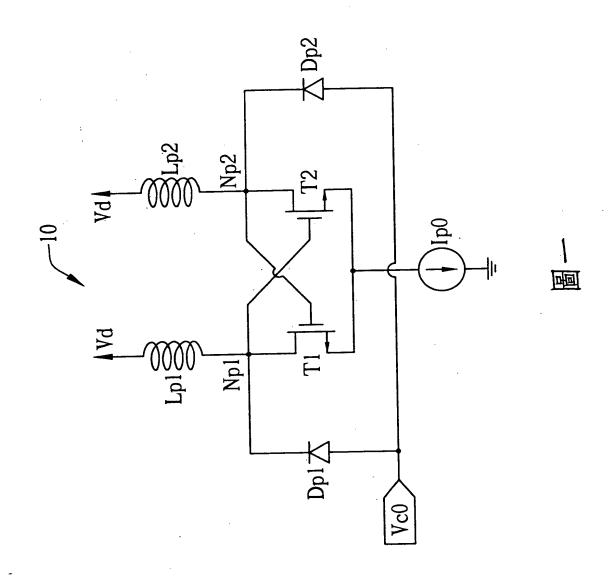
)

值固定的電容,電連於該第二輸出端及該第二可變電容之間。

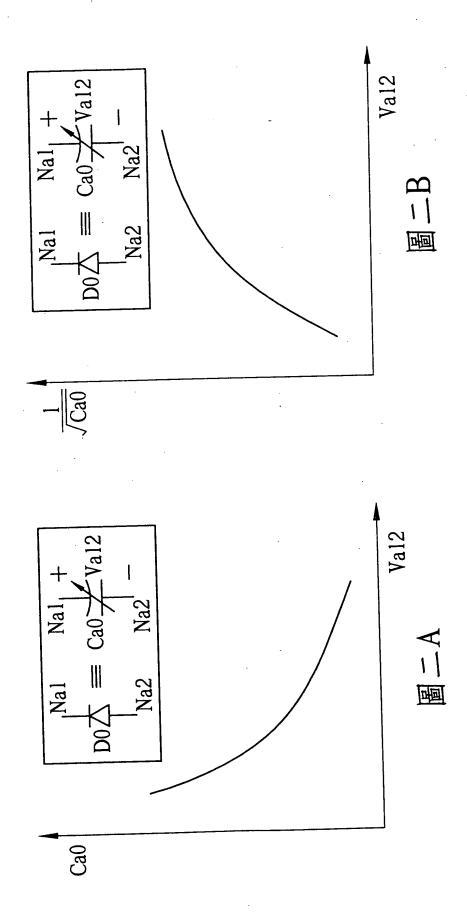
- 23. 如申請專利範圍第 18項之震盪器,其中該第二可變電容係連接於該第一可變電容與該第二輸出端之間。
- 24. 如申請專利範圍第23項之震盪器,其另包含有一電容值固定的電容,電連於該第二可變電容與該第二輸出端之間。
- 25. 如申請專利範圍第23項之震盪器,其中該第二可變電容接收該第二控制電壓的一端係連接於該第一可變電容接收該第一控制電壓的一端。
- 26. 如申請專利範圍第 18項之震盪器,其中該第一偏壓電壓之電壓值係一固定值。
- 27. 如申請專利範圍第18項之震盪器,其中該第二偏壓電壓之電壓值係一固定值。

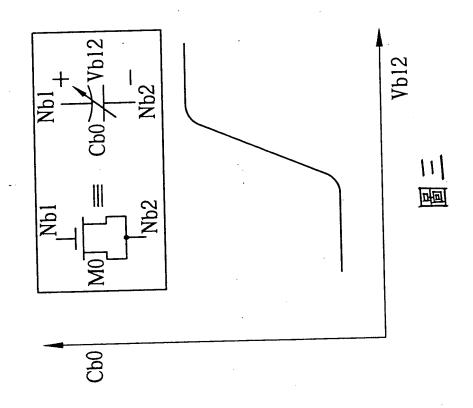






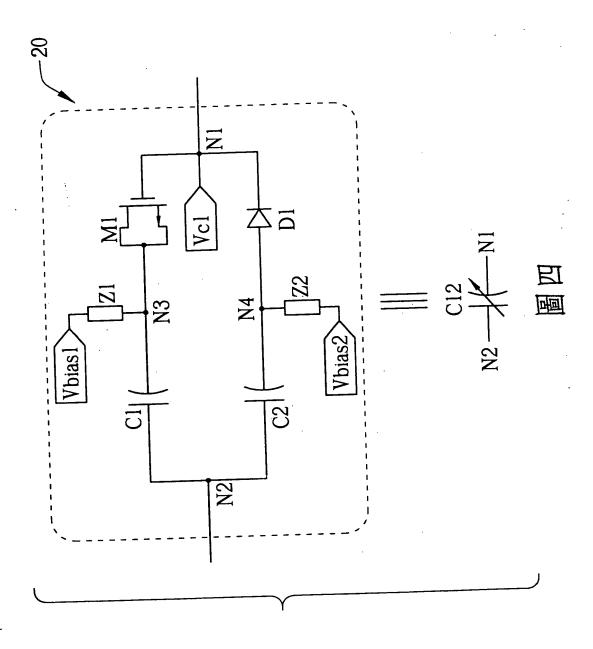
`)



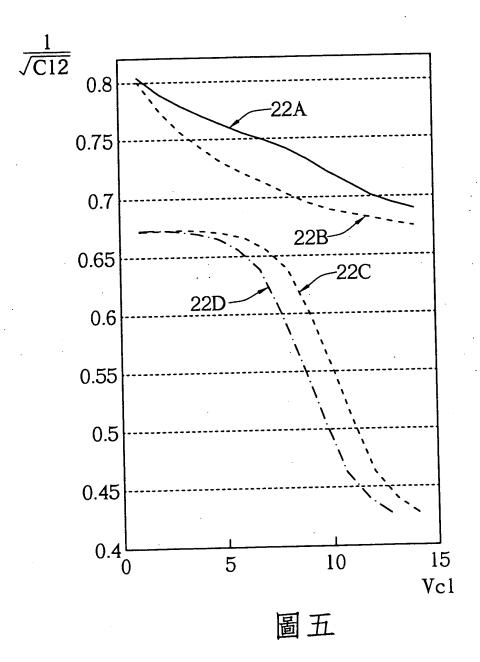


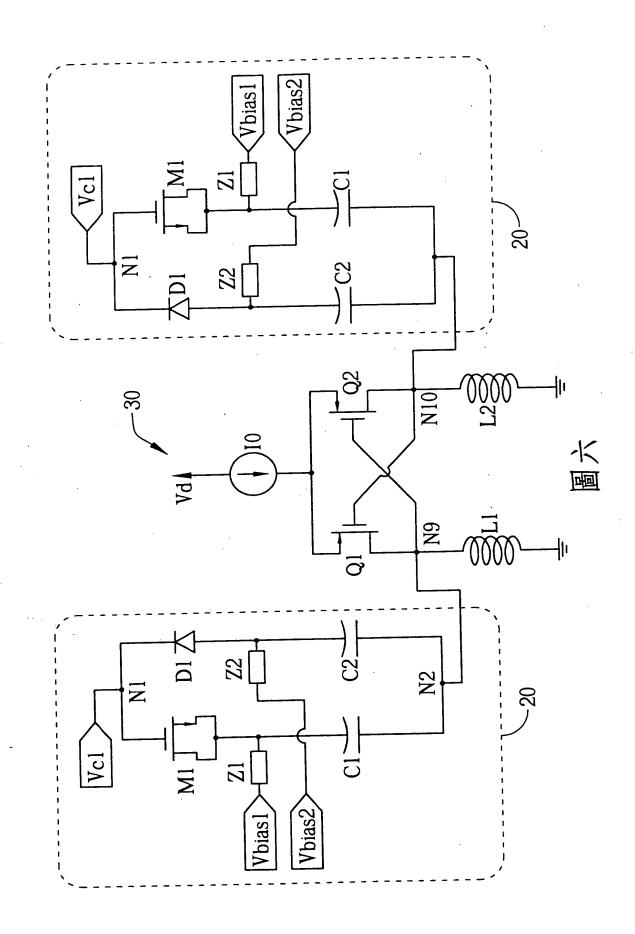
`

)



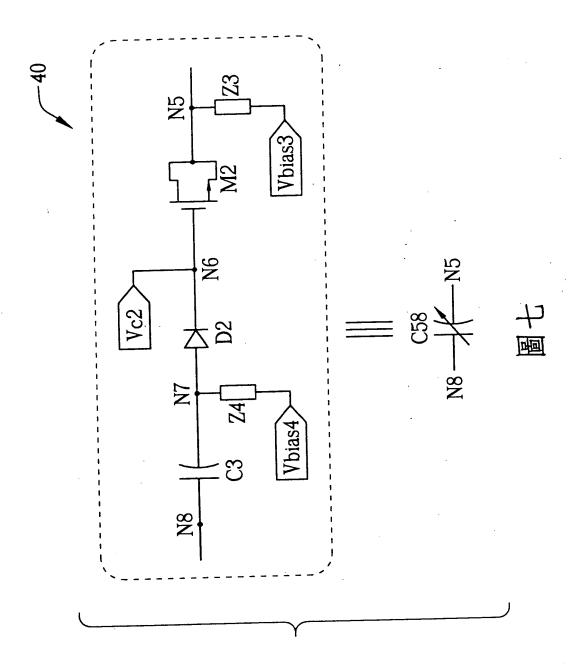
``



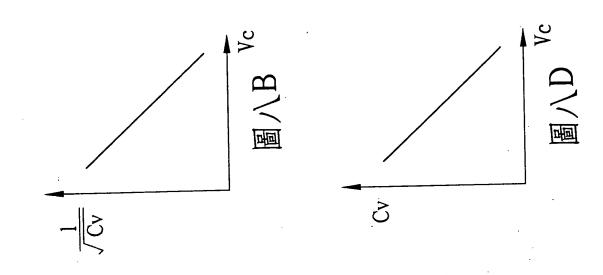


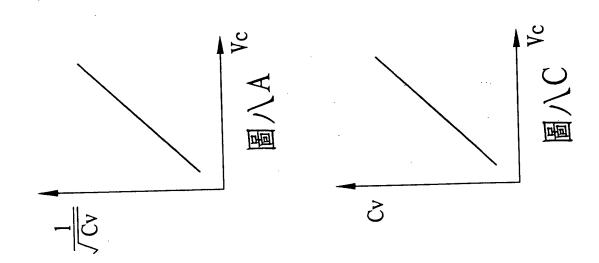
.

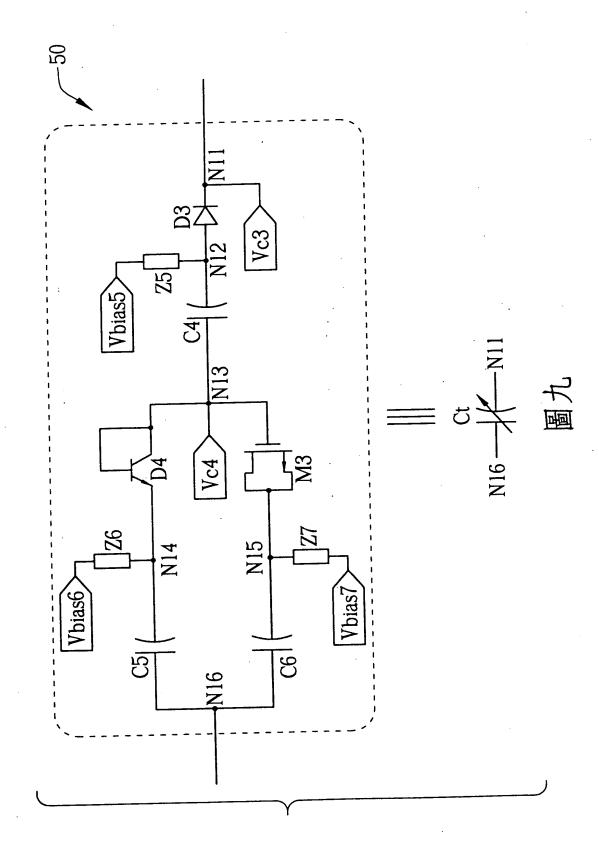
1

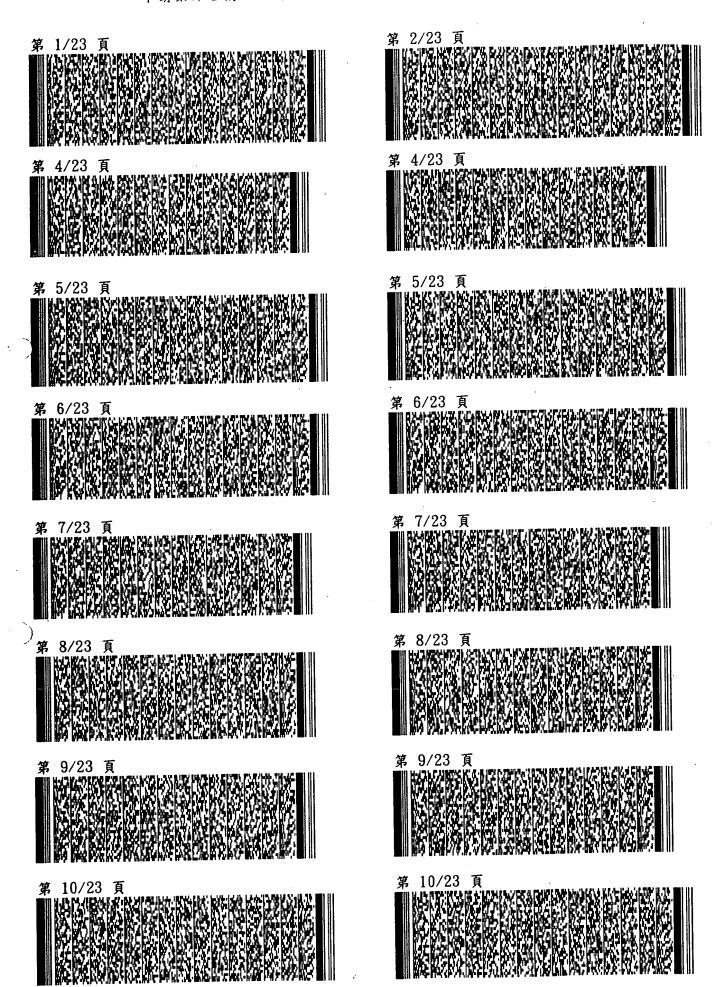


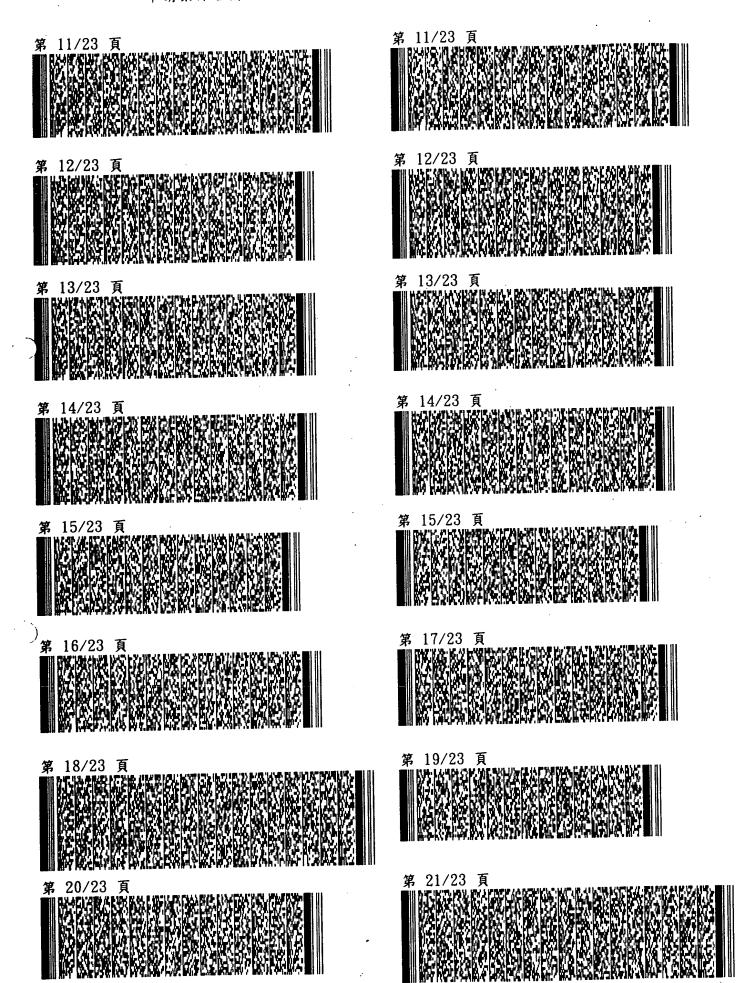
)











申請案件名稱:以二極體與金氧半電晶體組合的壓控電容電路及相關電路



